تاثیر دما و فرکانس بر خواص الکتریکی نانو کامپوزیت فتالوسیانین کلروایندیوم-پلی پیرول

محمد اسمعيل عظيم عراقي | سمانه محمودي*

گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده: در این پژوهش خواص الکتریکی و ساختاری نانو کامپوزیت فتالوسیانین کلروایندیوم و پلی پیرول (CIInPc + Ppy) بررسی شده است. در ابتدا نانوکامپوزیت در درصدهای ۵٪ و ۱۵٪ و ۲۵٪ سنتز شد و سپس قطعات ساندویچی با استفاده از دستگاه لایه نشانی تبخیر باریکه الکترونی تحت خلا ^۵-۱۰ میلیبار آماده شد. ظرفیت و عامل اتلاف این قطعات در بازهی فرکانسی ^۵۰۱-۱۰۰ هرتز و بازهی دمایی ۳۵۰ میلیبار آماده شد. ظرفیت و عامل اتلاف این قطعات در بازهی فرکانسی ^۵۰۵-۱۰۰ هرتز و بازهی درکانسی ^۲۰۵-۱۰۰ هرتز و بازهی دمایی ۳۵۰-۲۰۰ کلوین اندازه گیری شده است که نشان میدهد ظرفیت و عامل اتلاف با افزایش فرکانس ^۲۰۵-۱۰۰ هرتز و بازهی دمایی ۳۵۰-۲۰۰ کلوین اندازه گیری شده است که نشان میدهد ظرفیت و عامل اتلاف با افزایش فرکانس کاهش می باید. و ابستگی رسانندگی الکتریکی به فرکانس با رابطه ^۲۵۰ میلیبند. وابستگی رسانندگی الکتریکی به فرکانس با رابطه ^۲۵۰ مین می دهد ظرفیت و عامل اتلاف با افزایش فرکانس کاهش می باید. و ابستگی رسانندگی الکتریکی به فرکانس با رابطه ^۲۵۰ می می داده می شود که با توجه به این رابطه مکانیزمهای رسانش حامل ها مشخص می شود. غالب بودن هر مکانیزم رسانش وابسته به شرایط آزمایش و بازه های دمایی و فرکانسی است، که در این تحقیق مکانیزم هوپینگ غالب است. انرژی فعال سازی برای انتقال الکترونها برای سه درصد متفاوت کامپوزیت محاسبه شده که نشان می دهد انرژی فعال سازی با فزودن درصد پلیم رسانا کاهش یافته است. وضعیت مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی RESE مورد برسی قرار گرفته است.

واژ گان كليدى: خواص الكتريكى AC، فتالوسيانين، پلى پيرول، مكانيزم رسانش

std_samaneh.mahmoudi@khu.ac.ir

۱ – مقدمه

از دیرباز انسان مواد مختلفی را با هم ترکیب کرده است تا ماده ای جدید با خواص بهتر به دست آورد. کامپوزیتها ردهای از مواد پیشرفته هستند که در آنها از ترکیب مواد ساده به منظور ایجاد مواد جدید با خواص مکانیکی و فیزیکی برتر استفاده شده است. این مخلوط در مجموع و با توجه به برخی معیارها، خواص بهتری از هریک از اجزای تشکیل دهنده خود دارد. نانوکامپوزیت عبارت است از کامپوزیتی که حداقل یکی از اجزای تشکیل دهندهی آن در ابعاد نانومتر باشد. جز اصلی تشکیل دهنده نانوکامپوزیتها که

در برگیرنده فازهای دیگر می باشد، زمینه نانو کامپوزیت نامیده می-شود و جزء دیگر به عنوان تقویت کننده به منظور اهداف خاص از قبیل استحکام، مقاومت، هدایت الکتریکی، خواص مغناطیسی و... در درون زمینه توزیع می شود [۱]. در این کار تحقیقاتی فتالوسیانین کلرو ایندیوم با پلیمررسانا برای تقویت خواص الکتریکی به منظور استفاده در حسگر گازی کامپوزیت شده است. ساختار فتالوسیانینها شامل یک سیستم حلقوی متشکل از چهار واحد ایزوایندول است که توسط اتمهای نیتروژن به هم متصل هستند. فتالوسیانینها با علامت اختصاری Pc نمایش داده می شوند و دارای ترکیب شیمیایی (Ra Na) می باشند و معمولا به صورت نیمه رسانای P و دارای پایداری شیمیایی و حرارتی بالایی هستند [۲ و

۳] و در دو فرم کریستالی آلفا و بتا یافت می شوند که در شکل کریستالی α مولکولهای یک توده به صورت موازی با مولکول های تودههای مجاور قرار می گیرند، ولی در فرم β مولکولها در جهت مخالف با مولکولهای توده های مجاور قرارگرفتهاند و فرم β پايدارتر است در حالي که فرم α متخلخل تر است [و β]. فتالوسیانین ها با خصوصیاتی مانند تقارن بالا، صفحهای بودن مشخص می شوند و با توجه به اتمی که در میان حلقه های بنزنی قرار گرفته است کلاسه بندی می شوند [۴] که فتالوسیانین كلرواينديم با توجه به اتم هالوژنه در حلقه بنزني جزو فتالوسيانين-های هالوژنه است و تصویر ۱ ساختار آن را نشان میدهد. فتالوسیانین ها به عنوان یک رنگدانه شفاف در سلول های خورشیدی [۷ و ۸] و ترانزیستورها کاربرد دارند [۹] و همچنین نامزد خوبی برای طراحی سنسورهای گازی هستند [۱۰ و ۱۱] و ترکیب یک عنصر دوم با این ماده برای تقویت خواص حسگری روشی جدید و کارآمد است. در بعضی موارد جز دوم کامیوزیت نقش مهمی در فرآیند سنجش گاز دارد و ممکن است خواص حسگری لایه نازک را بهبود ببخشد و به انتقال بارها کمک کند. محدودهی گستردهای از مواد را می توان به عنوان جز دوم کامپوزیت استفاده کرد که در این پژوهش از پلیمر رسانا به عنوان تقویت کننده در خواص الکتریکی از جمله هدایت الکتریکی و تغییر در انرژی فعال π سازی استفاده شده است. پلیمرهای رسانا، پلیمرهایی با الکترون مزدوج هستند به طوریکه در ساختارشان، اتم های کربن ازطریق پیوند یگانه و دوگانه یک در میان به هم متصل شده اند و این پیوندها دائما با هم عوض می شوند. الکترون های π تنها درطول زنجیره پلیمر نامستقر هستند و از این رو از نظر الکترونی شبه تک بعدی هستند [۱۲]. در بین پلیمرهای رسانا متعدد، پلی پیرول (Ppy) به طور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته است [۱۳] زیرا مونومر پیرول دارای خواصی نظیر دسترسی تجاری، هدایت عالی و عملکرد بالا در فرآیند اکسایش و کاهش به خصوص در حسگرها است [۱۴و ۱۵]. باتوجه به اینکه غلظت و مقدار عنصر دوم درخواص کامپوزیت تاثیر گذار است در این تحقیق نانوکامپوزیتها در درصدهای مختلف سنتز شد و سپس قطعات ساندویچی از نانو کامپوزیتهای (ClInPc + Ppy) آماده شد و خواص الکتریکی و مورفولوژی در سه درصد متفاوت بررسی شد.



شكل ١: ساختار فتالوسيانين كلرواينديوم

۲- روش تجربی

نانو کامپوزیت کلرو ایندیوم فتالوس_یانین و پلی پیرول به روش شیمیایی سنتز شده است. ابتدا به ۳۰ میلی لیتر از ایزوپوپانول، مقدار ۰/۳۸ گرم فتالو سیانین کلروایندیوم و بعد از پنج دقیقه مقدار ۰/۰۲ میلی لیتر پیرول و ۰/۰۳ گرم پتاسیم پر سولفات به عنوان اکسنده اضافه شد. به مدت ۵ ساعت این مواد روی همزن هیترومگنت در دمای اتاق هم زده شدند وسیس ماده در داخل سانتریفیوژ به مدت یک دقیقه قرار داده شد تا رسوب آن از حلال جدا شود. ماده بدست آمده در داخل آون به مدت ۱ ساعت در دمای C ۲۰۰۰خشک شد و در نهایت پودر نانو کامپوزیت ۵ ٪ بد ست آمد. مراحل سنتز به ترتیب بالا برای در صدهای ۱۵٪ و ۲۵٪ نیز تکرار شد. برای ساخت قطعه از دستگاه لایهنشانی الكترون بيم كان مدل "HIND HIVAC-PC-3K" استفاده شده است. لايه آلومينيوم به ضخامت ۵ ± ۸۰ نانومتر به عنوان الکترود اول روی بستر شیشهای لایه نشانی شد و یک قطعه سیم مسی به و سیله چسب نقره بر روی آن چسبانده شد و بعد از آن در صدهای مختلف نانو کامپوزیت نیز با استفاده از دستگاه الکترون بیم گان با ضخامت های بین ۵۰۰–۴۵۰ نانومتر به عنوان لایهی میانی و لایه آلومینیوم دیگر به ضخامت ۵ ±۸۰ نانومتر به عنوان الکترود دوم لایه نشانی شد و سپس سیم مسی دیگر روی الکترود دوم چ سبانده می شود. تمام مراحل لایه ن شانی تحت خلا ٥-١٠ میلی بار الکترون بیم گان انجام شده است. ظرفیت و عامل اتلاف در بازه دمایی ۳۸۳–۳۰۸ کلوین و در بازه فرکانسیی ۱۰^۵ – ۱۰ هرتز با استفاده از LCR متر مدل MT4080 اندازه گیری شده است.

۳- نتایج و بحث

۳-۱- بررسی ساختاری

زمستان ۱۳۹۷| شماره چهارم | سال پنجم

سطح نانو کامپوزیتهای لایه نشانی شده روی شیشه توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مشخصه یابی شده است. شکل ۲ تصاویر (FESEM) نانوکامپوزیتها را در بزرگنمایی مختلف نشان می دهد. سطح لایه نازک به صورت دانه-های کروی یکنواخت است و اندازه ذرات بین ۳۰–۱۹ نانومتر است.



شکل ۲: تصویر میکروسکوپ الکترونی b, a) نانوکامپوزیت ۵٪ c) نانوکامپوزیت (f, e ۱۵٪ اناوکامپوزیت ۲۵٪ در بزرگنمایی های ۱۰۰و۲۰۰ نانومتر

آنالیز عنصری EDS (طیف سنجی تفرق انرژی پرتو X) بر روی یک منطقه سطحی از نمونهها توسط میکروسکوپ الکترونی انتخاب و انجام شده است. شکل ۳۵، ۳۵ و ۳۵ به ترتیب آنالیز عنصری نانوکامپوزیتهای ۵٪ و ۱۵٪ و ۲۵٪ را نشان میدهد و

تایید کننده وجود عناصر مورد انتظار است. بالاترین درصد مربوط به کربن است که نقش عمده را در ترکیبات آلی دارد.



زمستان ١٣٩٧ شماره چهارم | سال پنجم







شكل ۴: تغییرات ظرفیت برحسب a) فركانس b) دما برای نانو كامپوزیت (ClInPc+5%PPY)

شکل ۵: تغییرات ظرفیت برحسب a) فرکانس b) دما برای نانو کامپوزیت (ClInPc+15%PPY)



شكل ۶: تغييرات ظرفيت برحسب a) فركانس b) دما براي نانو كامپوزيت (ClInPc+25%PPY)

AC-۲- بررسی خواص الکتریکیAC

مقادیر ظرفیت در بازه فرکانسی۱۰۰ تا ۱۰^۵ هرتز و در بازه دمایی ۳۸۳–۳۰۸ کلوین برای نمونه های ۵ ٪ و ۱۵٪ و ۲۵٪ اندازه گیری

شده است. طبق نمودار شکل ۴۵، ۵۵ و ۶۵ برای سه درصد مختلف نانوکامپوزیتها ظرفیت با افزایش فرکانس کاهش می یابد و با افزایش دما افزایش پیدا میکند. در توجیه کاهش ظرفیت با افزایش فرکانس میتوان بیان کرد که اگر فرکانس میدان الکتریکی

پایین باشد به طوری که زمان بین دو جابهجایی قطب مثبت و منفی میدان بیشتر از زمان لازم برای چرخش مولکولهای دوقطبی باشد، دوقطبیها به طورکامل چرخیده و در جهت جدید قرار می گیرد ولی اگر فرکانس افزایش یابد به طوری که مولکولهای دوقطبی زمان کافی برای چرخش نداشته باشد چرخش مولکول محدود می شود و ظرفیت کاهش می یابد. این رفتار همچنین مطابق با رفتار ظرفیت در مدل گاسوامی –گاسوامی است [۱۶]. براساس این مدل تغییرات ظرفیت نسبت به فرکانس در مدار سری، مطابق رابطه ۱ است

$$C_{S} = \frac{1 + \omega^{2} C^{2} R^{2}}{\omega^{2} C^{2} R^{2}} = C + \frac{1}{\omega^{2} C^{2} R^{2}}$$
(1)

که R و $^{\rm Cs}$ به ترتیب مقاومت و ظرفیت مدار سری هستند. طبق معادله (۱) با فزایش فرکانس مقدار ظرفیت کاهش می یابد و در فرکانس بالا به مقدار ثابت C میل می کند. در این مدل ظرفیت C، که مستقل از از دما و فرکانس است با مقاومت درونی مواد R، موازی است و هر دو با مقاومت r به صورت سری هستند [۱۸]. با توجه به تصاویر ۴۵، ۵۵ و ۶۶ ظرفیت در فرکانس های بالا ($f > ^{\rm rot}$) با افزایش دما تغییری زیادی ندارد، در حالی که در فرکانس های پایین ($f < ^{\rm rot}$) که جهت گیری مولکول های دوقطبی آسان تر است، افزایش دما موجب افزایش تعداد حامل ها و افزایش ظرفیت می شود. طبق رابطه ۲ با افزایش دما، R کاهش می یابد و چون C_S به R نیز وابسته است باکاهش R، C_S نیز افزایش می یابد.

$$R = R_0 \exp(\Delta E / KT)$$
 (Y)

تصاویر ۷۵، ۷۵ و ۷C به ترتیب در بازه فرکانس ۱۰۰ تا ۱۰^۵ هرتز و دمای ۳۸۳–۳۰۸ کلوین برای کامپوزیت های ۵٪ و ۱۵٪ و ۲۵٪ نشان میدهد که مقادیر عامل اتلاف با افزایش فرکانس کاهش پیدا می کند. مطابق تئوری گاسوامی–گاسوامی [۱۷] عامل اتلاف طبق رابطه ۳ نوشته می شود.

$$tan\delta = \frac{1}{\omega RC} + \omega rC \tag{(7)}$$

در فرکانس پایین و دمای بالا جمله اول ($rac{1}{\omega RC}$) مطرح اســت که با افزایش فرکانس عامل اتلاف کاهش پیدا می کند. از طرفی در



فرکانس های بالا جملهی دوم ($\omega r C$) مطرح است که باعث افزایش عامل اتلاف است. در بین این دو جملهی رابطه ۳ یک کمینه وجود دارد که مقدار آن به صورت زیر است: $\omega_{min} = \left(\frac{1}{rRC^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ (۴)





شکل ۸ : تغییرات رسانندگی برحسب a) فرکانس و b) دمای T/ 1000 برای نانو کامپوزیت ۵٪



شکل ۹: تغییرات رسانندگی برحسب a) فرکانس و b) دمای T/ 1000 برای نانو کامپوزیت ۱۵٪



شکل ۱۰: تغییرات رسانندگی برحسب a) فرکانس و b) دمای T/ 1000 برای نانو کامپوزیت ۲۵٪

نمودار نانوکامپوزیت ۵٪ شــکل ۷a نشــان می دهد که در ســه دمای ۳۶۳، ۳۷۳ و ۳۸۳ کلوین این مینیمم دیده شــده اسـت ولی به علت محدودیت فرکانس مقدار کمینه برای دیگر قســـمت.ها مشهود نیست و مشابه این رفتار در چندین تحقیق هم مشاهده

شده است [۱۹ و ۲۰]. رسانندگی برحسب فرکانس در دماهای مختلف از رابطه ۵ بدست میآید. (۵) $\sigma_{ac}(\omega) = \omega C \tan \delta \frac{d}{A}$ که درآن d ضـخامت لایه نازک و A مسـاحت سـطح نمونه

می با شد. شکل ۸۵، ۹۵ و ۱۰۵ نشان می دهد که ر سانندگی با افزیش فرکانس افزایش می یابد. به طور کلی رسانندگی AC به فرکانس وابسته است و از قانون توانی پیروی می کند:

 $\sigma_{ac}(\omega) = A\omega^{s}$ (۶) که درآن A ثابت، $\varpi = 2\pi f$ فرکانس زاویه ای و s توان فرکانسی که درآن A ثابت، $\varpi = 2\pi f$ فرکانس زاویه ای و s توان فرکانسی (۱> s >۰) است. رسانندگی در فرکانس های بالاتر از ۱۰^{*} هرتز برای برای نانو کامپوزیت ۵٪ و ۲۵٪ افزایش می یابد که می توان بیان کرد نانو کامپوزیت ۱۵٪ و ۲۵٪ افزایش می یابد که می توان بیان کرد مکانیزم هوپینگ در این بازه های فرکانسی غالب است. انرژی فعال سازی از رابطه ۷ بدست می آید که کافی است شیب منحنی Ino را برحسب 1000/T رسم نمود.

 $\sigma = \sigma_0 \exp(Ea/KT)$ (۷) در رابطه ۷، Ea انرژی فعال سازی و K ثابت بولتزمن است. گاف انرژی نیز به صورت زیر تعریف می شود:

$$Ea = (Eg/2) \tag{A}$$

با توجه به شیب نمودار در تصاویر ۸۵، ۹۵ و ۱۰۴ انرژی فعال سازی برای سه درصد متفاوت کامپوزیت در جدول ۲، محاسبه شده است. انرژی فعال سازی به طور محسوس در فرکانس های ۱۰^۴،۱۰^۳ و ۱۰^۴ هرتز با افزودن پلیمر رسانا کاهش یافته است. می توان نتیجه گرفت امکان دارد که حساسیت این مواد با افزودن پلیمر رسانا زیاد شود و در توجیه این مورد بیان کرد که در فرآیند سنجش گاز، انتقال باری که بین حلقه های فتالوسیانین و پلیمر رسانا به عنوان پذیرنده (یا دهنده) با گاز به عنوان مولکول دهنده (یا پذیرنده) در جذب

سطحی گاز شکل می گیرد (هدایت الکتریکی) افزایش مییابد.

۴- نتیجه گیری

در این تحقیق قطعههای ساندویچی (ClInPc+%5 PPy) و (ClInPc+%25 PPy) و (ClInPc+%15 PPy) برای بررسی خواص الکتریکی AC در بازهی فرکانسی ۲۰۰–۱۰۰ هرتز و بازهی دمایی ۳۸۳–۳۰۸ کلوین ساخته شده است. اندازه گیریها نشان داد که در تمام نمونه ها ظرفیت با افزایش فرکانس کاهش و با افزایش دما، افزایش می یابد. عامل اتلاف نمونهها با افزایش فرکانس کاهش می یابد که این رفتارها مطابق با مدل گاسوامی-گاسوامی است. درتمام نمونهها رسانندگی با افزایش فرکانس افزایش می یابد و از رابطه $\sigma_{ac}(\omega) = A\omega^{s}$ پیروی می کند که این رفتار در بسیاری از ساختارهای لایه نازک دیده می شود و به انتقال حامل ها با مكانيزم هوپينگ مرتبط است. انرژی فعالسازی برای نمونهها محاسبه شد و نتایج نشان داد که با افزودن پلیمر رسانا انرژی فعال-سازی در فرکانسهای ۲۰^۴، ۱۰^۳ و^۵۰۱ هرتز کاهش مییابد. تصاویر FESEM نشان داد که ذرات به صورت کروی هستند و سایز ذرات کمتر از ۳۰ نانومتر است. آنالیز EDS درصد عناصر مورد انتظار را تایید می کند. این اطلاعات می تواند در ساخت قطعه برای حسگرهای گازی مهم و مفید باشد. با توجه به اینکه با افزایش درصد پلی پیرول انرژی فعالسازی کاهش یافته است، استفاده از این مواد به عنوان یک حسگر بهتر به دلیل انتقال مناسب حامل ها توجيه پذير ميباشد.

فرکانس (Hz)	انرژی فعالسازی(ClInPc+5%PPY) (ev)		انرژی فعالسازی(ClInPc+15%PPY) (ev)			انرژی فعالسازی(ClInPc+25%PPY) (ev)	
	1	•/••٣	_	۰/۰۴۱	١/٧٦٨	•/٧٣٣	•/••٧
۱۲۰	•/••٣	_	·/·۴۸	1/694	·/ATV	۰/۳۲۱	۰/۳۹۰
۱۰۰۰	•/٣۴٢	_	٠/١٩	1/841	1/104	•/154	-
1	١/٧٣۶	• /VY •	·///	-	·/۵٨·	•/٣٧٩	-
1	1/44	•/447	·/۳۵V	-	_	۰/۳۲۸	·/1VF

مدول ۱: انرژی فعال سازی نانو کامپوزیت ها

مراجع

[11] S. Pourteimoor, H. Haratizadeh, "Performance of a fabricated nanocomposite-based capacitive gas sensor at room temperature," J. Mater. Sci. Mater. Electron., 24, 18529–18534, 2017.

[12] H. Liu, X. B. Hu, J. Y. Wang, R. I. Boughton, "Structure, conductivity, and thermopower of crystalline polyaniline synthesized by the ultrasonic irradiation polymerization method," Macromolecules, 25, 9414–9419, 2002.

[13] J. Tabačiarová, M. Mičušík, P. Fedorko, M. Omastová, "Study of polypyrrole aging by XPS, FTIR and conductivity measurements," Polym. Degrad. Stab, 20, 392–401, 2015.

[14] S. Pirsa, N. Alizadeh, "Design and fabrication of gas sensor based on nanostructure conductive polypyrrole for determination of volatile organic solvents," Sensors Actuators, B Chem., 2, 461–466, 2010.

[15] I. Sapurina et al., "Polypyrrole nanotubes: The tuning of morphology and conductivity," Polym. (United Kingdom), 113, 247–258, 2017.

[16] A. Goswami and R. R. Varma, "157 Dielectric Behaviour of Dysprosium Oxide Films,", 98, 157–165, 1975.

[17] A. Goswami and A. P. Goswami, "Dielectric and optical properties of ZnS films," Thin Solid Film., 2, 175–185, 1973.

[18] M. E. Azim-Araghi, F. Pirifard, "Morphology, optical and AC electrical properties of nanostructure thin film of bromo indium phthalocyanine," Mater. Sci. Semicond. Process., 6, 1466–1471, 2013.

[19] M. Singh, A. Mahajan, N. Gupta, R. K. Bedi, "Study of junction charge transport properties of boron subphthalocyanine chloride thin film," Electron. Mater. Lett., 1, 118–126, 2015.

[20] M. Singh, A. Mahajan, R. K. Bedi, D. K. Aswal, "Dielectric Spectroscopic Studies of Boron Subphthalocyanine Chloride Thin Films," Electron. Mater. Lett., 1, 101–106, 2013.

[1] S. Varghese, "Natural rubber-based nanocomposites by latex compounding with layered silicates," 44, 4921–4927, 2003.

[2] Ü. Demirbaş, M. Pişkin, H. T. Akçay, B. Barut, M. Durmuş, H. Kantekin, "Synthesis, characterisation, photophysical and photochemical properties of free-base tetra-(5-chloro-2-(2,4dichlorophenoxy)phenoxy)phthalocyanine and respective zinc(II) and lead(II) complexes," Synth. Met, 223, 166–171, 2017.

[3] J. R. Miles, M. R. Willis, R. P. O. Jones, "Photoconduction properties of some monomeric phthalocyanines and dibromoanthrone," Mater. Sci. Semicond. Process, 15, 61–72, 2012.

[4] E. Kim, "Phthalocyanine Nanostructures", Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, 15, 629-689, 2004.

[5] H. S. Nalwa, Handbook of advanced electronic and photonic materials and devices. Academic Press, 2000.

[6] J. H. Chou, M. E. Kosal, H. S. Nalwal, N. A. Rakow, K. S. Suslick, The Porphryin Handbook, 2000.

[7] M. G. Walter, A. B. Rudine, C. C. Wamser,
"Porphyrins and phthalocyanines in solar photovoltaic cells," J. Porphyrins Phthalocyanines.,
9, 759–792, 2010.

[8] M. Mozaffari, A. Behjat, N. Torabi, "Application of copper phthalocyanin for surface modification of perovskite solar cells," J. Mater. Sci. Mater. Electron, 21, 18187–18192, 2018.

[9] J. D. Holbrey, "Industrial applications of phthalocyanines," J. Porphyr. Phthalocyanines, 437, June, 35–37, 2004.

[10] M. J. Jafari, M. E. Azim-Araghi, S. Barhemat, "Effect of chemical environments on palladium phthalocyanine thin film sensors for humidity analysis," J. Mater. Sci., 4, 1992–1999, 2012.



Influence of Temperature and Frequency on Electrical Properties Nanocomposite Chloroindium Phthalocyanine-Polypyrrole

M. E. Azim Araghi, S. Mahmoudi*

Faculty of physics, Kharazmi University, Tehran

Abstract: In this research work, the AC electrical properties of nanocomposite chloroindium phthalocyaninepolypyrrole were studied. Nanocomposites (ClInPc+%5 PPy) & (ClInPc+%15 PPy) & (ClInPc+%25 PPy) were synthesized and Subsequently sandwich devices (Al/ClInPc+PPy/Al) were prepared on pre-cleaned glass substrates, which were deposited in a high vacuum device of the electron-beam gun in the pressure of 10⁻⁵ mbar. Capacitance and Dissipation factor were measured in the range of 10²-10⁵ Hz frequency and 307-383 K temperatures. the capacitance and loss factor reduced by increasing the frequency and enhanced by increasing the temperatures. The AC electrical properties thin films of our materials are in good agreement with Goswami and Goswami model. The dependence of the electrical conductivity on the frequency is analyzed by the equation $\sigma(\omega) = A\omega^{S}$ which is typical for charge transport. The dominance of each mechanism depends on the experimental conditions and the temperature and frequency intervals. In this present research, the conduction mechanism is specified with hopping models. furthermore, the activation energies of the device are achieved as a function of frequency. The surface morphology of the nanocomposite thin film was investigated by field emission scanning electron microscope (FESEM) images.

Keywords: AC conductivity, Phthalocyanine, Polypyrrole, The conduction mechanism.